

(11) EP 0 783 107 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 09.07.1997 Patentblatt 1997/28

(51) Int. Cl.⁶: G01P 15/08

(21) Anmeldenummer: 96120428.6

(22) Anmeldetag: 18.12.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB IT NL

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 80333 München (DE)

(30) Priorität: 08.01.1996 DE 19600399

(72) Erfinder: Werner, Wolfgang, Dr.-Ing. 81545 München (DE)

(54) Herstellverfahren für ein mikromechanisches Bauteil mit einer beweglichen Struktur

(57) Zur Vermeidung von Sticking-Effekten vor dem Freilegen der beweglichen mikromechanischen Struktur diese über eine Hilfsstruktur mit einer geeigneten Halterung, bspw. dem Substrat verbunden und diese Hilfs-

struktur erst nach dem Freilegen entfernt. Das Verfahren ist kompatibel mit IC-Fertigungsprozessen für integrierte Schaltungen.

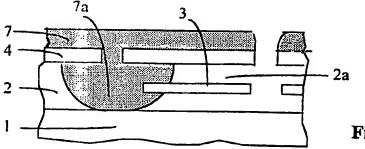


Fig.4

10

30

40

Die Erfindung betrifft ein Herstellverfahren für ein mikromechanisches Bauteil mit einer beweglichen mikromechanischen Struktur.

Mikromechanisches Bauteile mit einer beweglichen Struktur besitzen ein weites Anwendungsgebiet, beispielsweise als Motoren oder Kraftsensoren (Beschleunigungs- oder Neigungssensoren). Dabei besteht ein großes Interesse an Herstellverfahren, die mit der Fertigung von integrierten Schaltungen, insbesondere auf einem Silizium-Substrat kompatibel sind. Nur eine Kompatibilität der Herstellungsprozesse erlaubt die Integration von Mikromechanik und Ansteuer- und Auswerteschaltungen in Mikrosystemen. Dies ist auch dann wichtig, wenn bestehende Halbleiterfertigungsanlagen auch zur Herstellung von mikromechanischen Strukturen genutzt werden sollen.

Bei den üblichen Herstellverfahren wird die bewegliche Struktur durch eine isotrope, meist naßchemische, Entfernung einer sie umgebenden Schicht freigelegt. Dabei besteht das Problem, daß ein Verkleben der beweglichen Teile mit ihrer Unterlage (sogenanntes Sticking) auftritt. Dieser Effekt wird verursacht durch Adhäsionskräfte, die bei Strukturen mit geringen Abständen, typischerweise < 1 μ m, sehr groß sind.

Eine bekannte Lösung dieses Problems sieht vor, nach dem Freiätzen der beweglichen Teile das Ätzmittel oder ein nachfolgend verwendetes Spülmittel (z. B. Wasser) durch eine sublimierende Chemikalie zu ersetzen. Das Bauteil wird dann abgekühlt, so daß die bewegliche Struktur von einer dünnen Schicht dieser Chemikalie umgeben ist, welche anschließend sublimiert. Geeignete Chemikalien sind z. B. Cyklohexan oder Dichlorbenzol. Da die benötigten Chemikalien nicht in der notwendigen Reinheit zur Verfügung stehen, ist dieses Verfahren nicht kompatibel mit der Fertigung von integrierten Schaltkreisen. Insbesondere ist es nicht für die Herstellung von Mikrosystemen einsetzbar.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Herstellverfahren für ein mikromechanisches Bauteil mit einer beweglichen Struktur anzugeben, bei dem der Sticking-Effekt vermieden wird.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Die Erfindung beruht auf dem Einsatz einer Hilfsstruktur, mit welcher die bewegliche Struktur vor ihrem Freiätzen an einer als Halterung dienenden Schicht befestigt wird. Die bewegliche Struktur wird dann freigelegt, indem eine sie umgebende Zwischenschicht isotrop naßchemisch entfernt wird. Dabei bleibt die bewegliche Struktur aber über die Hilfsstruktur mit der Halterung verbunden. Die beim Trocknen auftretenden Adhäsionskräfte können daher nicht zu einem Verkleben der beweglichen Struktur mit beispielsweise dem Untergrund führen. Erst danach wird die Hilfsstruktur entfernt, so daß die bewegliche Struktur vollständig beweglich wird.

Als Halterung kann beispielsweise das Substrat selber oder eine feste Struktur des mikromechanischen Bauteils dienen. Sie kann unter- oder oberhalb der beweglichen Struktur oder auf gleicher Höhe mit ihr liegen. Beim Entfernen der Zwischenschicht muß sie mit dem Substrat und über die Hilfsstruktur mit der beweglichen Struktur verbunden bleiben.

Die Hilfsstruktur besteht aus einem Material, welches beim Entfernen der Zwischenschicht nicht angegriffen wird und welches am Ende des Verfahrens einfach entfernt werden kann. Geeignet ist hierfür beispielsweise Fotolack.

Um die Hilfsstruktur wie gefordert herzustellen, wird eine Öffnung in der Zwischenschicht derart erzeugt, daß die Oberflächen der beweglichen Struktur und der Halterung teilweise freiliegen. Dann wird eine fotoempfindliche Schicht (Fotolack) aufgebracht, wodurch in der Öffnung die Hilfsstruktur erzeugt wird, so daß sie die bewegliche Struktur und die Halterung verbindet. Aus der fotoempfindlichen Schicht wird mithife einer Belichtung und Entwicklung eine Maske hergestellt, deren Maskenöffnungen das Freilegen der beweglichen Struktur ermöglichen. Durch die Maskenöffnungen hindurch wird also die Zwischenschicht geätzt.

Bei dem Verfahren werden ausschließlich Prozesse eingesetzt, die auch bei der Herstellung von integrierten Schaltungen benutzt werden, so daß die geforderte Kompatibilität vorliegt.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Die Figuren 1 bis 4 zeigen einen Querschnitt durch ein Halbleitersubstrat mit einem mikromechanischen Bauteil, an dem die Verfahrensschritte verdeutlicht werden.

- Ausgangspunkt für das Herstellverfahren ist FIG 1 ein Silizium-Substrat 1, auf welches eine Zwischenschicht 2 und eine bewegliche Struktur 3 aufgebracht sind. Die Zwischenschicht 2 besteht beispielsweise aus Siliziumdioxid und kann auch aus gleichen oder verschiedenen Teilschichten bestehen. Sie umgibt die später freizulegende bewegliche Struktur 3, die beispielsweise aus Polysilizium oder einem Metall besteht, vollständig. Die Anordnung weist auch eine obere Schicht 4 auf, aus der eine feste Struktur des mikromechanischen Bauteils gebildet wird und die aus demselben Material wie die bewegliche Struktur bestehen kann.
- FIG 2 Es wird eine Fotomaske 5 aufgebracht, und mit dieser werden die obere Schicht 4 und die Zwischenschicht 2 geätzt. In diesem Beispiel erfolgt die erste Ätzung anisotrop und die zweite isotrop. Es können aber auch andere Ätzprozesse eingesetzt werden. Die Öffnung 6 in der Zwischenschicht muß so dimensio-

55



5

10

30

35



niert sein, daß ein Teil der beweglichen Struktur 3 und ein Teil einer geeigneten Halterung freiliegen. In diesem Fall werden sowohl das Substrat 1 als auch die obere Schicht 4 als Halterung verwendet.

FIG 3 Die Lackmaske 5 wird entfernt und eine neue Fotolackschicht 7 aufgebracht, die die Öffnung 6 auffüllt und hier die Hilfsstruktur 7a bildet. Die Fotolackschicht 7 dient gleichzeitig als Maske für die Freiätzung der beweglichen Struktur 3.

FIG 4 Für die Freiätzung muß in diesem Beispiel zunächst die obere Schicht 4 geätzt werden, anschließend wird die Zwischenschicht 2 um die bewegliche Struktur 3 herum mittels eines üblichen isotropen Ätzprozesses vollständig entfernt. Die bewegliche Struktur 3 ist nun über die Hilfsstruktur 7a mit der Halterung, hier also dem Substrat 1 und der oberen Schicht 4, verbunden. Die obere Schicht 4 ist außerhalb der Zeichenebene bspw. über nichtentfernte Teile der Zwischenschicht 2 fest mit dem Substrat verbunden. Anschlie-Bend wird die Fotolackschicht 7 einschließlich der Hilfsstruktur 7a mit Hilfe eines O2-Plasmas oder Ozon entfernt, so daß die bewegliche Struktur vollständig freigelegt wird.

Patentansprüche

- Herstellverfahren für ein mikromechanisches Bauteil mit einer beweglichen Struktur auf einem Halbleitersubstrat.
 - bei dem die bewegliche Struktur (3), eine Zwischenschicht (2) und eine als Halterung (1, 4). dienende Schicht oder Struktur derart erzeugt werden, daß die bewegliche Struktur (3) in die Zwischenschicht (2) eingebettet ist und von der Halterung (1, 4) durch einen Teil der Zwischenschicht getrennt ist.
 - bei dem eine Öffnung (6) in der Zwischenschicht (2) erzeugt wird, die die bewegliche 45 Struktur (3) und die Halterung (1, 4) teilweise
 - bei dem eine Fotolackschicht aufgebracht wird, so daß in der Öffnung (6) eine Hilfsstruktur (7a) erzeugt wird, die die bewegliche Struktur (3) 50 und die Halterung (1, 4) miteinander verbindet,
 - bei dem die Fotolackschicht zu einer Maske strukturiert wird, die eine Öffnung zum Freilegen der beweglichen Struktur besitzt,
 - bei dem in einem Ätzprozeß durch diese Öffnung hindurch die Zwischenschicht (2) in der Umgebung der beweglichen Struktur (3) entfernt wird, und
 - bei dem danach die Hilfsstruktur (7a) mithilfe

eines Trockenätzprozesses entfernt wird.

2. Herstellverfahren nach Anspruch 1, bei dem als Halterung das Halbleitersubstrat (1) und/oder eine feste Struktur (4) des mikromechanischen Bauteils verwendet wird.

3

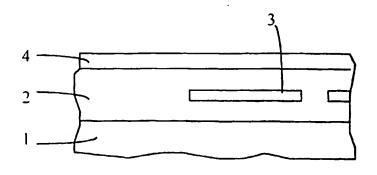


Fig. 1

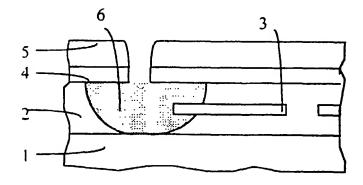


Fig. 2

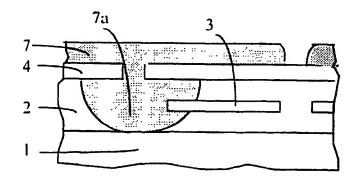
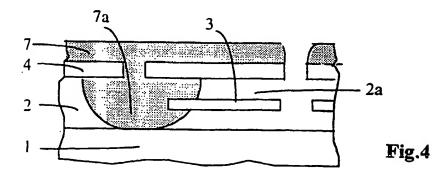


Fig.3





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeidung EP 96 12 0428

		GE DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebli	ents mit Angabe, soweit erforderlich, chen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CL6)
X	WO 93 21536 A (ANA) 28.0ktober 1993 * Seite 9, Zeile 16 Abbildungen 3-12 *	LOG DEVICES INC) 5 - Seite 15, Zeile 2;	1,2	G01P15/08
P,X	(DE)) 18.Januar 199	MENS AG ;KOZLOWSKI FRAN 96 - Zeile 24; Abbildung		
E	EP 0 766 090 A (SIE * Spalte 5, Zeile 4 Abbildung 1 *	EMENS AG) 2.April 1997 14 - Spalte 6, Zeile 6;	1,2	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
				G01P
Der vo	rliegende Recherchenbericht wurd	de für alle Patentansprüche erstellt	-	
	Betherchesort	Abschlaßdatum der Recherche		Prifer
	DEN HAAG	23.April 1997	Nes	smann, C
X : von Y : von	KATEGORIE DER GENANNTEN I besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kate unologischer Hintergrund atschriftliche Offenbarung	E: ilteres Patente tet nach dem Anm z mit einer D: in dez Anmeldi	okument, das jedos eldedatum veröffen ing angefliketer De	tlicht worden ist

EPO FORM 1503 03.82 (POSCOS)